

特点

- 单2.7V - 3.6V电源
- 串行接口架构
- 页编程操作
 - 单周期重新编程（擦除和编程）
 - 4096页（264字节/页）主内存
- 两个264字节的数据缓冲器 - 允许接收数据，同时重新编程非易失性存储器
- 内部的计划和控制的定时器
- 快速页编程时间 - 7毫秒典型
- 120 μ s典型的页面缓冲传输时间
- 低功耗
 - 4毫安有效的读电流典型
 - 2 μ A CMOS待机电流典型
- 10 MHz的最大时钟频率
- 硬件数据保护功能
- 串行外设接口（SPI）兼容 - 模式0和3
- CMOS和TTL兼容输入和输出
- 商用和工业温度范围

描述

该AT45DB081是一个只有2.7伏，串行接口闪存适合于-系TEM重新编程。其8650752位存储器组织为4096页264字节每个。除了在主存储器中，AT45DB081还包含两个每264个字节的数据缓冲器。该缓冲器允许同时在一个页面接收数据的主存储器进行重新编程。与传统的闪存是具有多个地址线和并行接口，所述数据闪存，随机存取采用串行接口，以顺序地存取其数据。简单的串行接口的制造厂itates硬件布局，提高了系统可靠性，最大限度地降低开关噪声，并

引脚名称和信号持续时间

引脚名称	功能
\overline{CS}	芯片选择
SCK	串行时钟
SI	串行输入
SO	串行输出
\overline{WP}	硬件页写保护引脚
RESET	芯片复位
RDY / BUSY	就绪/忙

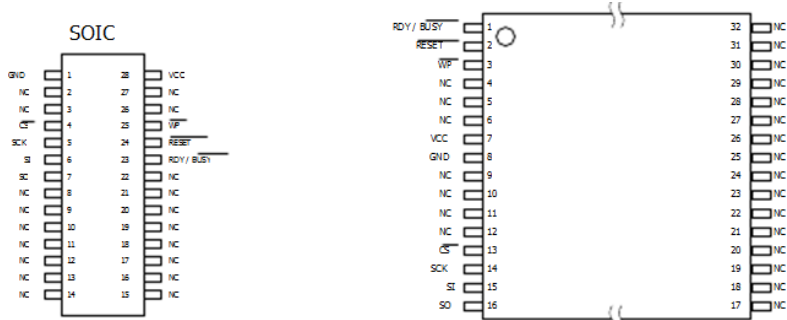
TSOP顶视图
类型1



8-Megabit
2.7伏只
串行
数据闪存™

AT45DB081

(续)



框图

